

**MOS FIELD EFFECT TRANSISTORS  
MOS-FELDEFFECT-TRANSISTOREN**

Type Typ	Channel Kanal	Maximum ratings ● Grenzdaten						$R_f$	$\gamma_{21}$	at bei	$U_{CE}$	$I_C$	$U_{GE}$	$C_i$	Case Gehäuse
		$U_{CE}$ $U_{CEM}^*$ V	$U_{GE}$ $U_{GEM}^*$ V	$U_{GC}$ V	$I_C$ mA	$P_{tot}$ mW	$\theta_j$ °C	$R_{CE(ON)}^*$ $R_{CE(OFF)}^*$ $\Omega$	mS		V	mA	V	pF	
KF520	N	30	$\pm 70^1)$	—	30	300	175	$\geq 10^{13}$	$\geq 0,3$	15 10	5 1...3	0'	8	T20	
KF521	N	20 <sup>2)</sup> *	$\pm 20^*$	—	10	100	150	$230 \leq 300^*$ $10^9 \geq 10^8 \bullet$	$3,5 \geq 2,5$	6 0,1 0,1	5	0	3	T13	
KF522	P	-32	-40 <sup>3)</sup>	-40	-50	200	125	$110 \leq 150^*$	2...5	-10 -10	-0,1 $-20 \geq -10$ -10	-15 -10	3	T13	
KF523	P	-32	-40 <sup>3)</sup>	-40	-50	250	125	$110 \leq 150^*$	2...5	-10 -10	-0,1 $-20 \geq -10$ -10	-15 -10	11	T46	

KF522, KF523:  $U_{(BR)GBS\ max} = \pm 70\ V^4)$

1)  $U_{CE} = 15\ V$

2)  $U_{GIE} = -6\ V$

3)  $U_{GE} \leq 0\ V$

4) Two non-repeating voltage impulses of both polarity,  $t_{ip} \leq 10\ ms$ , with current limiting on  $10\ \mu A$  ● Zwei nicht wiederholte Impulse von beider Polarität,  $t_{ip} \leq 10\ ms$ , mit Strombegrenzung auf  $10\ \mu A$ .

**DUAL MOS FIELD EFFECT TRANSISTORS WITH CHANNEL P  
DOPPEL-MOS-FELDEFFECT-TRANSISTOREN MIT KANAL P**

Type Typ	Maximum ratings ● Grenzdaten					$-U_{GET}$	at bei	$-U_{GE}$	$I_{CE}$	$\Delta U_{GET}$	$r_{CE(ON)}$	$r_{CE(OFF)}$	Case Gehäuse
	$-U_{CEM}$ $-U_{ECM}$ V	$-U_{GEM}$ V	$-U_{GCM}$ V	$-I_{CEM}$ mA	$P_{tot}$ mW	V		V	$\mu A$	V	k $\Omega$	M $\Omega$	
KF552	10	30	30	15	100	2...6	=	$-U_C$	10	$\leq 0,5$	— $\leq 1^1)$ —	— $\geq 100^1)$	T27

1)  $f = 10\ kHz$

**JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTORS WITH CHANNEL N FOR VERY HIGH SPEED CIRCUITS  
AND CHOPPERS  
SPERRSCHICHT-FELDEFFECT-TRANSISTOREN MIT N-KANAL FÜR SEHR SCHNELLE  
SCHALTERANWENDUNGEN UND MESSZERHACKER**

Type Typ	Maximum ratings ● Grenzdaten				$R_{DS(ON)\ max}$	$I_{DSS}$	at bei	$U_{GS}$	$U_{DS}$	$-U_{GS(OFF)}$	at bei	$U_{DS}$ ( $I_D = 1\ nA$ )	$t_{ON\ max}$	$t_{OFF\ max}$	at bei	$I_{D(ON)}$	$-U_{GS(OFF)}$ 1)	Case Gehäuse
	$U_{GSS}$ V	$U_{DS}$ V	$I_G$ mA	$P_{tot}$ mW	$\Omega$	mA	V	V	V	V	V	ns	ns	mA	V			
KS4391	-40	40	10	300	30	1	0	20	4...10	20	20	35	12	12		T11/1		
KS4392	-40	40	10	300	60	1	0	20	2...5	20	20	55	6	7		T11/1		
KS4393	-40	40	10	300	100	1	0	20	0,5...3	20	20	80	3	5		T11/1		

1)  $U_{DD} = 10\ V, U_{GSX} = 0\ V$

